可視光照射で誘起されるグラファイトーダイヤモンド構造相転移の初期過程理論

大西 宏昌¹,那須 奎一郎^{1,2} 物質構造科学研究所¹ CREST-JST²

Theory for early stage of graphite-diamond structural phase transition induced by visible light irradiation

Hiromasa Ohnishi¹ and Keiichiro Nasu^{1,2} Institute of Materials Structure Science¹, CREST-JST²

1. はじめに

この世にありふれた " 煤 " に過ぎないグラファイトか ら,ダイヤモンドを如何に効率よく合成するかという科学 技術は,世界中の企業が長年膨大な研究費を費やして模索 してきた問題であり,然も,物性物理学上でも極めて大き な純学術的命題である。これが効率良く実現すれば,希少 な宝石としての価値,更には,工業的応用上の価値など, その経済的効果には,計り知れないものがあろう。従来の 合成法は,3000度,15G Paと云う高温高圧でグラファイ トを圧縮する [1,2],或いは,極めて高エネルギーのガン マー線やX線等を照射してグラファイトに衝撃波を与える [3,4],等々,将に力ずくで,一挙に,グラファイトをダイ ヤモンドに変換する方法である。

しかし,極く最近,これらの高温高圧法や衝撃波を一切 用いず,僅かな可視光照射によって,グラファイトからダ イヤモンドへ,微視的レベルで滑らかに,量子的・局所的・ 逐次的に相転移させていく方法が,阪大産研の谷村等によ り提案され,注目を集めている[5]。之は,一種の光誘起 相転移に他ならない。

もし,これが実現すれば,光励起の局所性を最大限に活 用して物質の新機能を創成する,究極の光量子科学技術と 言えよう。

この状況に鑑み、本研究では、僅か数個の可視光を照 射することによって発生する励起状態のナノ・ドメインを 介して、グラファイトがダイヤモンドへと、量子的レベル



で,滑らかで且つ逐次的に変換されていくこの非平衡相転 移を,その初期過程に限定して,純理論的立場から,大規 模数値計算を実行することによって解明する。

2. 光誘起構造相転移

Fig.1に象徴的に示すように,対象となる物質に僅か数 個の可視光を照射しただけで,その物質の格子構造,電子 状態,磁気的性質,等の物性が巨視的に変化し,照射前の その物質の基底(熱平衡)状態とは全く異なる励起状態の 巨視的ドメイン(分域)が出来る。このような不思議な非 平衡相転移現象が,15年程前程から様々な物質で次々と 発見され,光誘起相転移と呼ばれ,多くの国内外の研究者 の興味を集めている。この種の研究は,当初,有機分子性 結晶から始まったのであるが,現在では,分子性結晶各種 には留まらず,遷移金属錯体結晶,各種ペロブスカイト型 金属酸化結晶,Biの様な単純金属結晶,等々,広汎な物 質で行われている[6,7]。

光誘起構造相転移の実験的研究手法に於いても,当初 は,可視光照射で起きた非平衡相転移を,別の"やはり" 可視光を用いて計測すると云う,所謂,従来型の可視"変 調"分光法の枠内に留まっていた。しかし,現在では, KEK-IMSS-PFで,既に盛んに行われているように,発生 した非平衡相転移を硬・軟X線を用いて時間分解で計測し, 格子構造,電子状態,磁気的性質,等の巨視的変化を直接 解明できる状況に到っている。

更に,極々最近に於いては,前述の硬・軟X線時間分 解法に加え,テラ・ヘルツ波分光,電子線時分割回折法, STM,等も加わり,光誘起相転移による巨視的ドメイン 生成過程の動力学が,フェムト秒の精度で,総合的且つ詳 細に解明されようとしている [6.7]。

3. 熱平衡相転移, 非平衡相転移, 潜在的多重安定性

前述如く,既に様々な物質で光誘起相転移現象が観測されてはいるが,決してあらゆる物質で,この非平衡相転移が起きるわけではない。僅か数個の可視光照射にも拘らず, 巨視的な数の原子や電子が集団で変化を起こすのであり, その為には,Fig.1に概念的に示すように,対象となる物 質に何等かの潜在的多重安定性が,既に備わっていなけれ ばならない[8]。その物質の真の基底(熱平衡)状態の他に, 格子構造こそ大きく基底状態とは異なるが,エネルギー的 には基底状態より僅かに高いだけの(擬縮退した),別の 巨視的状態(擬基底状態)が存在する状況である。

このように,潜在的多重安定性と宣言してしまうと,極 めて特別な状況にも聞こえるが,決してこれは特別ではな い。身近なキッテルの教科書によれば,NaClと云う物質 では,イオン性状態と共有結合状態が対立しているが,僅 かにイオン性状態が低いので,所謂 "塩"がこの世に出 現するのだと云う [9]。如何なる物質も何らかの潜在的多 重安定性は持っており,絶対に安定な物質などあろうはず もない。

温度を絶対零度にして、もう少しだけ正確に考えよう。 真の基底状態とこの擬基底状態との(結晶の単位胞当りの) エネルギー差が、幸いにも室温熱エネルギーと同じ程度で あれば、当然、温度を絶対零度から上昇させていけば、普 通の熱平衡相転移として、この擬基底状態は、実際に出現 するであろう。しかし、不幸にして、このエネルギー差が 室温熱エネルギーより遥かに大きい場合、この擬基底状態 (相) は、通常の世界では永遠に実現できない。このよう な不幸な場合ですら、可視光照射によれば、フランク・コ ンドン型電子励起とその後の格子緩和を経て(Fig. 1)、励 起状態が増殖(proliferation)し、結晶全体ではなくとも、 有限サイズの巨視的ドメインとして、この擬基底状態を生 成させる事が出来るのである。

これは、一種の励起状態なので、当然、一定時間経てば 完全に消失する。しかし、前述の各種測定技術を駆使すれ ば、現在では、極短時間内でも対象となる状態(相)の種々 の物性的特性は十分な精度で測定する事が可能である。ピ コ秒程度の寿命さえあれば十分な場合が殆どであり、フェ ムト秒以内であっても測定可能な物理量は多い。巨視的ド メインとして、実際に実現しさえすれば、寿命が有限であ る事自体は、現代の各種測定技術を駆使すれば、それ程研 究の障害にはならない。

4. グラファイトとダイヤモンド

この潜在的多重安定性の観点から,1cm³ 当り10²³ 個程, 巨視的に凝縮した炭素(C)の集団を顧みると,この物質 には,周知の如くsp²の平面6員環積層構造をもつグラフ アイト相と,sp³の3次元4配位T_d構造をしたダイヤモン ド相がある。絶対零度で常圧の状況を考えれば,真の基 底状態はグラファイト相に他ならず,ダイヤモンド相は, Fig.2に鎖線で示すように0.02 eV/carbonだけエネルギー の高い擬基底状態である[10]。絶対零度で常圧の状況を考 えれば,巨視的に凝縮した炭素(C)の集団には,将に, 潜在的な多重安定性が備わっている。

グラファイトからダイヤモンドへの最も単純な構造相 転移経路は, Fig. 2 に示すように, グラファイトの6員環 面に垂直に, 面を折り曲げるようジグザグに炭素原子が 変位(バックリング)し, 同時に, 層間距離が 3.35Å から 1.54Å へ短縮するものである。この経路は仮想的なもので あるが, 局所密度汎関数法を用いれば, これに対応する断



Figure 2 Graphite and diamond, photo-excitation (\rightarrow), high temperature and high pressure synthesis (-->).

熱的障壁の高さを計算することが出来, 0.3 eV/carbon 程の 値が得られている [11]。

しかし,この計算は,10²³ 個の全ての炭素原子が同時に 一様に運動するという,微視的ではなく,巨視的条件下で の計算である。従って,実際にこれに対応する転移を起こ すには,0.3 eV×10²³ の程度の巨大なエネルギーが必要と なる。常温の熱揺らぎではこの断熱的障壁を越える事は出 来ない。

この事情を反映し, グラファイトからダイヤモンドをつ くる従来からの合成法は、前述の如く, 3000度, 15G Pa と云う高温高圧でグラファイトを圧縮する, 或いは, 極め て高エネルギーのガンマー線やX線等を照射してグラファ イトに衝撃波を与える,等々, 力ずくで, 一挙に, グラフ ァイトをダイヤモンドに変換する方法である。

5. 可視光誘起グラファイトーダイヤモンド転移

これに対し,前述の如く,極く最近,これらの高温高圧 法や衝撃波を一切用いず,僅かな可視光照射によって,グ ラファイトからダイヤモンドへ,局所的・逐次的に相転移 させていく方法が,阪大産研の谷村等により実験的に提案 された [5]。之は,前述の光誘起相転移に他ならない。



Vs = -40mV

Figure 3 STM image, after the visible laser lights irradiation, dotted lines are only for eye guide.





Figure 4 Time resolved electron diffraction intensity, after the visible laser lights irradiation, The time difference between the irradiation and the diffraction measurement is written in the right side.

Fig. 3 に示すように、約 1.6 eV のフェムト秒レーザー・ パルスをグラファイト面に45度に偏光させ照射すると、 1000 個程度の炭素原子を含む新しいドメインが生成し、 このドメイン内では、6員環の炭素原子のうち、4個は結 晶の外側に飛び出し、2個が内側に沈むというバックリン グを起こしている事が,STM イメージから判明した。面 内偏光励起だけでは何も起きず、且つ、ピコ秒パルス励 起でも、この変化は全くおきない。励起強度依存性の測定 からは、線形でも極端な多光子過程でもなく、5光子程度 の数光子過程である事も解った。この構造変化は室温でも 10日程は安定であると云う。STM,及び可視部の反射ス ペクトルの時間分解測定から,ドメイン内で実現している 電子状態の性質も,ある程度は推定することが出来る。元々 半金属状態にあったグラファイトのフェルミ面近傍には, この半金属から絶縁体に転移したと思われる擬ギャップが 観測されている [5]。

Raman 等により [12],レーザー照射後の時分割電子線回 折法による研究も、谷村等に先駆けて、全く独立に行われ ている。これによれば、Fig. 4 に示す如く、レーザー照射後、 時分割電子線回折測定を行うと、グラファイトの元々の層 間距離 3.35Å による回折ピークの他に、照射後 14 ピコ秒 後に、1.9Å 付近にも新しい回折ピークが現れ、消えてい くと云う結果が得られている。

6. 初期過程の概念

以上の研究結果を元にして考えられるこの非平衡相転移 機構の概念が Fig. 5 である。グラファイト層面に,並行で はなく,垂直に偏光した可視光を照射すると,層間を跨ぐ 電荷移動励起が発生し,その電子 (e⁻)正孔(h⁺)間クーロ ン引力により,隣接する2層が接近するように歪み,確率 は数%程度ではあるが,局所的な層間σ結合が形成される。

周知の如く、グラファイトは電気の良導体で、発生した 電子(e⁻)と正孔(h⁺)の大部分は、通常の正負の自由な 光キャリアーとして、相互に反対方向に量子拡散し消失す



Figure 5 Concept for early stage.

る。しかし,確率は数%程度ではあるが,このような自発 的併進対称性の破綻と電子正孔対自己局在化によるσ結合 が形成される。このσ結合は,例え一本のみ形成されたと しても,反作用として平面的だったグラファイト層内の広 い領域で前述のバックリング(歪んだ層面に垂直な周期的 な変形)を誘起する。

更に,このσ結合の増殖に併行して,層間でのズリ(shear) 変形が自発的に起きる。つまり,元の菱面体型グラファイ ト結晶構造のまま,単に2層が接近しただけでは,層間σ 結合の位相不整合が発生する。この位相不整合は,自発的 ズリ変形により修正され,安定な結合を持つダイヤモンド 様の励起ナノ・ドメインが完成する。

数個の可視光照射により,このような励起ドメインが幾 つか出来,相互に連結・増殖し,潜在的多重安定性と相俟 って,巨視的ダイヤモンド構造へと相転移する。

この構造相転移を電子状態の変化と云う点から見れば, 元々のグラファイトの電子系は,周知の如く平面6員環型 sp²結合に由来する半金属的状態にある。しかし,層間 σ 結合が形成されれば,そこだけ3次元 sp³結合を持つ4配 位のダイヤモンドのナノ・ドメインとなり,絶縁体へ転移 する。この絶縁体のドメインが,半金属に浸された状態と なり,フェルミ面近傍には真のギャップではないが,擬ギ ャップが開くことになる。

7.構造と電子状態の計算

この考えに基づき,我々は格子構造変化に関しては変分 法,電子状態に関しては標準的な局所密度汎函数法を用い て,光励起からダイアモンド様ドメイン生成までの相転移 経路上での断熱ポテンシャル面の計算を行った[13]。 前述の如く,相転移機構の初期過程の基本的性質を解明 するには,隣接する2層のグラファイトのみを考えれば十 分なので,Fig.6の様な2層に跨る変分的相転移経路を考 える。Fig.6a),b)のL₀,θ,Δz,Δx,δは格子変形の変分パラ メータで,夫々,ドメインの半径,ドメイン巾,ドメイン の深さ,ズリ変形,バックリング巾に対応する。Fig.6b) はこのバックリングを表し,Fig.3に基づき,第1層では, グラファイトの6員環面に垂直に,面を折り曲げるよう, 4個の炭素原子は上に,残る2個は下に,ジグザグに変位し, 第2層では,これの逆とする。尚,バックリングは六員環



Figure 6 Trial pattern for structural change, a) Global pattern, b) Buckling and shear



Figure 7 The total adiabatic energy increase relative to the graphite, as a function of $(\Delta z + \delta)$.

の重心を保存すると仮定した。

以後,この種のダイアモンド様ドメインを、ダイヤモン ドとグラファイトの掛け合わせの意味で"ダイヤバイト" (Diaphite) と呼ぶ (Nature (London, UK) Vol.458 (2009), page 129)。2層のグラファイト中に埋め込まれたダイアバ イトを密度汎函数法で計算する際、このダイアバイト本体 の特性を解明する事と、本体の周囲に十分に広がった母体 のグラファイトとの境界を解明する事の双方が極め重要で ある。従って、全系の併進対称を仮定できない。この為、 本研究では水素で縁取った約 (250×2) 個の炭素クラスタ ーにつき計算し、Fig. 7 の結果をえた。

この Fig. 7 の横軸は、(Δz+δ) で, Fig. 6 に戻ると,元々 のグラファイトの位置から,バックリングも含めて最も内 側に侵入した炭素の z 方向変移を表す。結局,元々のグラ ファイトの層間距離が約 1Å 程短縮した所に,障壁の峠(約 3.4 eV)があり,その後,ダイヤバイト・ドメインに対応 する安定点(約 3.3 eV)が現れる事が解る。このダイヤバ



Figure 9 Diaphite with a more higher energy

イトの構造は Fig. 8 に示してあるが, バックリングしたま まで 2 層が接近したもので (Δz=0.5Å), バックリングは 大きいが (δ=0.07Å), ズリ変形は極く小さい。この Fig. 8 に書いていない炭素は, ほぼ元の位置のままで, このドメ インは約 30 個程の炭素原子からなる (θ=0.3Å)。元のグ ラファイトの位置からこの障壁を越えるには, Fig. 7 に模 式的に示すように, Franck-Condon 励起で, 可視レーザー 光量子約 3 個分で十分である事が解り, 且つ, 一旦ダイヤ バイト・ドメインが出来れば, 室温熱揺らぎ程度では元の グラファイトへ戻ることも出来ない事がわかる。

結局,我々は,巨視的炭素集団を対象にし,先ず,全て の炭素原子の位置をグラファイトの基底状態の位置(原点) に固定し,そこからの多次元格子変移座標空間における全 系の断熱ポテンシャル・エネルギーを計算し,原点から, エネルギー的にも,距離的にも,最も近い第一のダイヤバ イト・ドメインを変分で見出したのである。一度,この状 態が生成すれば,次のレーザー光を吸って,図7にあるよ うな過程を繰り返し,新たな障壁を乗り越えて,よりエネ ルギーが高く,格子変移も大きな第2,第3のダイヤバイト・ ドメインへと増殖していく事が出来る。

実際,前述した計算を更に進めると,前述のものよりエ ネルギーが高く, L_0 , θ , Δz , Δx , δ が大きく,且つ変分パラ メータの極小点を与える準安定状態は,幾つも出てくる。 その典型例を Fig. 9 に示す。この Fig. 9 のダイヤバイト・ ドメインは約300個程の炭素原子からなり, Fig. 8 よりズ リ変形も大きく, Fig. 3 の STM イメージとも, 又, 所謂 ヘクサゴナル・ダイヤモンドとも似ている。Fig. 8,9の構 造におけるフェルミ面近傍での電子の状態密度も当然計算 できるが, この結果では, 擬ギャップが開いているので, 半金属に浸された絶縁体である事も解る。

8. 終わりに

こうして,可視光照射で誘起されるグラファイトーダイ ヤモンド構造相転移の初期過程の様子は,かなり解ってき た。本研究では,転移の速度や量子力学的確率の説明は, 長さの都合上,割愛したが,6章で述べた初期過程に関す る自発的併進対称性の破綻と自己局在化の量子的確率の計 算も,既に終っている[14]。今後は,初期過程の後に来る より古典的拡散型増殖過程,体積変化,等も考えていく予 定である。

尚,本研究は,文科省科研費「特別推進:光誘起相転移動力学」の一環であり,阪大産研の谷村克己教授との共同研究である。

引用文献

- [1] F. Bundy, The Journal of Chemical Physics 38, 631(1963).
- [2] T. Irifune, A. Kurio, S. Sakamoto, T. Inoue and H. Sumiya, Nature 421, 599 (2003).
- [3] F. Banhart, J. Appl. Phys. 81, 3440 (1997).
- [4] H. Nakayama and H. Yoshida, J. Physics CM 15, R1077(2003).
- [5] J. Kanasaki, E. Inami, K. Tanimura, H. Ohnishi and K. Nasu, Phys. Rev. Letters **102** (2009) 087402 (1-4).
- [6] S.Koshihara, Journal of Physics (IOP, London,UK), Conference Series, Vol.148 (2009).
- [7] K. Yonemitsu and K.Nasu, Physics Report (Elsevier), 465, (2008), pages 1-60.
- [8] K. Nasu, Photo-induced phase transitions, (World Scientific, Singapore, 2004).
- [9] C.Kittle, Introduction to Solid State Physics, Seventh edition (John Wiley, New York, 1996), p. 53.
- [10] D. Brenner, Phys. Rev. B 42, 9458 (1990).
- [11] S. Fahy, S. Louise and M. Cohen, Phys. Rev. B 34, 1191 (1986); 35, 7623 (1987).
- [12] R. K. Raman, Y. Murooka, C. Ruan, T. Yang, S. Berber and D. Tomanek, Phys. Rev. Lett. **101**(2008) 077401.
- [13] H. Ohnishi and K. Nasu, Phys. Rev. B 79 (2009) 054111.
- [14] L. Radosinski, K. Nasu, J. Kanazaki, K. Tanimura, A. Radosz and T. Luty, Nano-scale sp²-sp³ conversion by visible lights irradiation and photoinduced phase transitions, "Molecular electronic and related materials-Control and probe with light", ed by Naito Toshio, 2009, (Trans-world Research Network Publisher, Kerala, India), in press.

(原稿受付日:2009年3月16日)

著者紹介

大西 宏昌 Masahiro OHNISHI



高エネルギー加速器研究機構 放射光科学第一研究系 研究員 TEL:029-864-5593 Email:ohni@post.kek.jp 略歴:2006年高知大学大学院理学研 究科博士課程修了,2006年高エネル ギー加速器研究機構物質構造科学研究 所放射光科学第一研究系研究員,現在

に至る。

最近の研究:光誘起構造相転移,第一原理計算。 趣味:テニス

那須 奎一郎 Keiichiro NASU



高エネルギー加速器研究機構 放射光科学第一研究系 教授 TEL: 029-864-5588 FAX: 029-864-3202 Email: knasu@post.kek.jp 略歴: 1970 年東北大学理学部物理学 科卒, 1975 年東北大学大学院理学研 究科博士課程修了, 1977 年東京大学

物性研究所助手,1982年分子科学研究所分子基礎理論第 2部門助教授,1992年高エネルギー物理学研究所放射光測 定器研究系教授,1993年高エネルギー加速器研究機構物 質構造科学研究所教授,現在に至る。

最近の研究:光誘起相転移理論,経路積分型光電子分光理 論。

趣味:ジョギング,野天風呂, ラーメン